





	<h2 style="color: red;">FDB029N06</h2> <p>codice articolo del costruttore: FDB029N06</p> <hr/> <p>Costruttore / Marca: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Parte della descrizione: MOSFET N-CH 60V 120A D2PAK</p> <hr/> <p>Schede tecniche:  FDB029N06.pdf</p> <hr/> <p>Stato di RoHs: Senza piombo / RoHS conforme</p> <hr/> <p>Condizione di scorta: New original, 26763 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Nave da: Hong Kong</p> <hr/> <p>Modo di spedizione: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

specificazioni

Numero di parte	FDB029N06
fabbricante	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Descrizione	MOSFET N-CH 60V 120A D2PAK
Categoria	Prodotti a semiconduttore discreti > Transistor-FET,
Stato parte	26763 pcs Stock
Produttore tempi di consegna standard	15 Weeks
Descrizione dettagliata	N-Channel 60V 120A (Tc) 231W (Tc) Surface Mount
Serie	PowerTrench®
Tecnologia	MOSFET (Metal Oxide)
temperatura di esercizio	-55°C ~ 175°C (TJ)
Tipo montaggio	Surface Mount
Contenitore / involucro	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Contenitore dispositivo fornitore	D ² PAK
Dissipazione di potenza (max)	231W (Tc)
Tipo FET	N-Channel
Caratteristica FET	-
Tensione drain-source (Vdss)	60V
Corrente - Drain continuo (Id) @ 25 ° C	120A (Tc)
Rds On (max) a Id, Vgs	3.1 mOhm @ 75A, 10V
Vgs (th) (max) a Id	4.5V @ 250µA
Carica Gate (Qg) (Max) @ Vgs	151nC @ 10V
Capacità di ingresso (Ciss) (Max) @ Vds	9815pF @ 25V
Tensione dell'azionamento (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
imballaggio	Tape & Reel (TR)
Stato senza piombo / Stato RoHS	Lead free / RoHS Compliant
Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Altri nomi	FDB029N06TR


FDB029N06 è nuovo originale in magazzino, ricerca datasheet FDB029N06, PDF, inventario Y-IC.com online, ordine FDB029N06 AMI Semiconductor / ON Semiconductor con garanzia e garanzia. RFQ FDB029N06: Info@Y-IC.com

Potresti essere anche interessato:

 <p>FDB0250N807L Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 240A D2PAK</p>	 <p>FDB035AN06A0 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 80A TO- 263AB</p>	 <p>FDB0260N1007L AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 200A D2PAK</p>	 <p>FDB029N06 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 120A D2PAK</p>
 <p>FDB0250N807L AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 240A D2PAK</p>	 <p>FDB0300N1007L AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 200A D2PAK</p>	 <p>FDB031N08 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 75V 120A D2PAK</p>	 <p>FDB0300N1007L Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 200A D2PAK</p>

Hot Parts

Di Più

 FDB016N04AL7	 FDB016N04AL7	 FDB024N04AL7	 FDB024N04AL7	 FDB024N06
 FDB024N06	 FDB024N088L7	 FDB029N06	 FDB031N08	 FDB031N08
 FDB035AN06A0	 FDB035AN06A0	 FDB035AN06AO	 FDB035AN06_F085	 FDB035N10A
 FDB035N10A	 FDB038AN06AO	 FDB039N06	 FDB039N06	 FDB045AN08AO
 FDB045AN08AO	 FDB045AN08AO	 FDB045AN08_F085	 FDB047N10	 FDB047N10
 FDB050AN06AO	 FDB050AN06AO	 FDB050AN06AO	 FDB060AN08AO	 FDB060AN08AO
 FDB060AN08AO	 FDB070AN06AO	 FDB070AN06AO	 FDB070AN06_F085	 FDB075N15A
 FDB075N15A	 FDB075N15A_F085	 FDB082N15A	 FDB082N15A	 FDB088N08
 FDB088N08	 FDB10AN06AO	 FDB10AN06AO	 FDB10AN06AO	 FDB10N20C
 FDB110N15A	 FDB110N15A	 FDB120N10	 FDB120N10	 FDB12N50

Contact us:Info@Y-IC.com

AGGIUNGI: Unità A5-B5 n. 509, 5 / F Sing Win Factory Building, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

